

附件1

“新型显示与 略性电 材料” 点 项
年度项目申报 南

“ ” 创 部 安 ，
“ ” 材 ” 。

本 案 的 部 ， 布 2021 报 。

本 标 ： 产 安 大 程

导 ， 产 ， 打 创 ，

材 备 的 ，

、 、 、 备等 材 的

。

2021 部 持 导 、 步 、 出 的

、 第 代半导 材 、 大

材 3 ， 按 “ 础 、

、 ” 层 ， 25 ， 安 拔

3.79 。 ， 部 7 ， 安 拔

2100 ， 300 ； 部 4 部 。

按 标 （ 1.1）的 报。

持 1~2 ， 不超 4 。 报 的

必 标 的 部 标。

基础 不超 4 ，参单 不超 6 ；
 单 不超 10 。 1 ，
 1 。
 不 ，参单 不超 3
 。 1 ，
 1983 1 1 出 ， 1981 1 1
 出 ， 参
 本 部 采 部 (称
 标)。 部 ，
 创 报 。
 部 ， 道 报，但 报
 不 单 单 。
 “ 持 1~2 ” : ，当
 出 报 、 不 的
 ， 持 2 。 2 采 持
 的 。第 成 2 ，
 持 。

材

()
 : 大尺寸衬底 低 、 波长
 Micro-LED 长 ， Micro-LED

的低，Micro-LED尺寸、边的
Micro-LED Micro-LED；背板
Micro-LED成，单Micro-LED。

标：大尺寸衬底（≥6寸）10 cm×10 cm
、Micro-LED波长差 $\leq \pm 1$ nm；尺寸 $< 5 \mu\text{m}$ ，
0.3 A/cm²，EQE别 $\geq 35\%$ 、 $\geq 25\%$
 $\geq 10\%$ ，衬底（≥6寸） $\geq 99.9\%$ ；（465±5 nm）
FWHM < 20 nm，（525±5 nm）FWHM < 25 nm，（630±5
nm）FWHM < 22 nm；单Micro-LED：尺寸 ≥ 0.5 寸，
辨 ≥ 2000 dpi， ≥ 6000 cd/m²，等 ≥ 10 bits；
 ≥ 25 ，PCT ≥ 5 。

比彩（
、部）
：Micro-LED的备
；Micro-LED的低材
，衬底Micro-LED玻背板
；触EL Micro-LED测
，比的，彩
Micro-LED，并程。

标：尺寸 ≥ 10 寸，ppi ≥ 170 ，辨 $\geq 1920 \times 1080$ ，
 $< 150 \mu\text{m}$ ，尺寸 $< 30 \mu\text{m}$ ， ≥ 2000 cd/m²，

≥ 80%， 等 ≥ 10 bits， 比 ≥ 1000000:1；

≥ 25 ， PCT ≥ 5 。

超 辨 ()

: 超 辨 、 的 、
备 测等 ， 串 、 材 、 、
波 、 、 变等 ， 备出
LCoS ； LCoS LD 的
； LCoS 的
， 并 成测 表 。

标: 出 的超 辨 LCoS
， ≥ 2π， 辨 3840×2160 (4K)
7680×4320 (8K)， ≥ 0.6" (4K) ≥ 1.2" (8K)，
≥ 180 Hz， ≥ 90%， ≥ 80%， 等 ≥
10 bits， 比 ≥ 4000:1， ≥ 400 cd/m²， ≥ 20000 。

≥ 25 ， PCT ≥ 5 。

材

(础)

: 触、
， 包的 荡、 、
； 触、 材 的
备 尺 案 ； ，

场、产、的
超表等倍；成，
备；触、
触测的。
标：

$\geq 0.4 \text{ m}$, $\geq 30 \text{ Hz}$;
 程 $< 1700 \text{ R}$; 变参 $< 1 \text{ nm}$, 超
 薄 场 ≥ 30 ,
 PCT ≥ 6 。
 彩 材 (、部
)
 : 材 、 材
 , 备
 成 材
 程 ; 、
 充、 备; 、 低
 。
 标: 材 ≥ 3 ; 彩
 尺寸 ≥ 10 寸, 彩 $\geq 50\% \text{ NTSC}$, < 30
 ms , 辨 $\geq 180 \text{ ppi}$, $< 10 \text{ mW/}$ 寸, ≥ 1.5
 ; 产的 充 备:
 成 $\pm 5\%$, $\pm 5 \mu\text{m}$; ≥ 30 ,
 PCT ≥ 5 。
 材 (、部
)
 : 大 , 、 、
 比的 半导 材 ; 代

产的 靶材的 程 ； 产的
薄 (TFT) 的 ， 代
TFT 产 ； 低 、 低 的低
- (LTPO) 背板 。

标: 1.场 $>40 \text{ cm}^2/\text{Vs}$; 比 $\geq 10^9$ 。

测 $\text{PBTS} < 0.5 \text{ V} @ V_{\text{gs}} = 20$
 $\text{V}, V_{\text{ds}} = 0.1 \text{ V}, 1, = 60^\circ\text{C}$; $\text{NBTS} < 1.0 \text{ V} @ V_{\text{gs}} =$
 $-20 \text{ V}, V_{\text{ds}} = 0.1 \text{ V}, 1, = 60^\circ\text{C}$;

$\text{NBTIS} < 2.0 \text{ V} @ V_{\text{gs}} = -20 \text{ V}, V_{\text{ds}} = 0.1 \text{ V},$ 导
1, $= 60^\circ\text{C}$, (白 LED) $> 10000 \text{ cd/m}^2$ 。 2.

TFT 导 产 (G8.5 代); LTPO
导 产 (G6 代

2 -

:

， GaN 材

的。

标： 650V 等 产 GaN 材

产， 6~8 寸 Si 衬底 GaN 层 错 $< 1 \times 10^8 \text{cm}^{-2}$ ，

$< 300 \Omega/\text{sq}$ ， $< 3\%$ ； 等 650 V 的

GaN 比导 $< 4 \text{m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ ， 导 $< 30 \text{m}\Omega$ ，

不超 12%； $\geq 1.5 \text{kW}$ 的 GaN

AC-DC (220 V-48 V) $\geq 300 \text{kHz}$ ，

$\geq 98\%$ ， $\geq 100 \text{W}/\text{in}^3$ ， 出 波 $< 0.5\%$ ，

THD $< 5\%$ ， 的 ；

≥ 10 ， / / 标 ≥ 2 。

长波 材 ()

： 代 纯 LED ，

In InGaN 材 的 长、

LED ， LED

， 纯 LED 产。

标： 波长 $\geq 520 \text{nm}$ LED， $20 \text{A}/\text{cm}^2$

WPE $\geq 50\%$ 、 $\geq 240 \text{lm}/\text{W}$ ； 波长 $\geq 565 \text{nm}$ LED， $20 \text{A}/\text{cm}^2$

WPE $\geq 30\%$ 、 $\geq 180 \text{lm}/\text{W}$ ； 成 InGaN

长波 LED 产 ； 出 纯 LED

产 ， $< 2700 \text{K}$ ， ≥ 90 ， 灯 ≥ 150

lm/W ； ≥ 10 ， / / 标 ≥ 2 。

尺寸材料
 的 ()
 : 、 带、
 尺寸 LED 材 备 ; 超
 成 ; 尺寸 LED
 备 , 测等
 的 ; 产 车 尺寸 LED 材
 的产 , 车
 车灯 的 。

标: LED 错 $< 5 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}$,
 $< 300 \text{ ps}$; LED 3dB 带 $\geq 1.5 \text{ GHz}$,
 传 $\geq 10 \text{ m}$, 尺寸 LED MIMO $\geq 50 \text{ Gbps}$,
 LED 成 $< 1 \text{ cm}$; LED
 变 $< 5\%$ (半 $< 20 \text{ mm}$); 产材
 尺寸 LED 的 灯 $\geq 200 \times 60$, 灯 出
 $\geq 3000 \text{ lm}$, 别 $\geq 300 \text{ m}$, 别 $\geq 90\%$,
 别 $> 100 \text{ m}$, 别 $\geq 80\%$; 传、
 等 3 ; ≥ 10 ,
 / / 标 ≥ 2 。

带半导 材
 (础)

: 带半导 材 的

， 、 变、 、
等材带、
的，材— —的测
；超的带半导
材的备、，场、
等的测、传传等半
导的材，第代半导材
的材。

标：出材
， ≥ 50000 ， $\geq 90\%$ ，出
 ≥ 2 ()；带半导材
 ≥ 3 ，出超半导 ≥ 2
；材备出
产的 ≥ 2 ；登 ≥ 10 ，
报 1。

大尺寸单衬底备产 ()
：大尺寸 4H-SiC 单长
，；SiC 单长的
，长程、
，大尺寸、低成本 SiC 单的产。SiC 衬底
表、参等，、低
的 大尺寸 SiC 单衬底表粗糙。

标: 6 寸 SiC 衬底材 产, 6 寸 SiC
 衬底(004) 的 XRD 摆 半 < 45 arcsec, TTV < 10 μ m,
 LTV < 2 μ m, WARP < 30 μ m, 表 粗糙 < 0.2nm; 半
 SiC 衬底的 < 0.3cm², $\geq 1 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$; 导 衬底
 的 < 0.1cm², < 0.025 $\Omega \cdot \text{cm}$, <
 1000 /cm², 错 < 400 /cm²; 8 寸 SiC 单 大
 203mm, 4H 比 大 95%, 大 90%, XRD 半
 < 60 arcsec; 大 0.3 μ m 的 0.5 /cm²;
 ≥ 10 , / / 标 ≥ 2 。

材 (础)
 : 、低
 的 , 的 测材 ;
 材 的 触、 案;
 测 、 的 成 ;
 的 , 场 的 。

标: 材 ≥ 2 , 编程 < 1
 pJ、编程 < 50 ns、成 $\geq 16 \text{ Mb}$;
 编 、 的 ; ≥ 2
 的 测材 , 传 测 $\geq 10^{10} \text{ Jones}$, 测
 $\geq 320 \times 256$; 测 的 成; 存
 的 , 测 标 别等 的
 ; ≥ 20 , / / 标 ≥ 1 。

材 存 (础

)

： 传 存储 的 ，
 材 成 ； 道
 存 的
 ， 不 的 ；
 磁材 的 操 磁 ； 产
 的 — 、低 材 备
 ； 道 材 的 标 ；
 存 单 。

标： CMOS 的 —
 、低 材 ≥ 2 ； 磁磁 的
 $< 8 \times 10^6 \text{A/cm}^2$ ， 磁 ≥ 3 ； 成 道
 磁存储 材 成，磁存储 穿磁 \geq
 150%， $< 0.5 \text{pJ/bit}$ ， 次 $\geq 1 \times 10^{12}$ ， 保持 ≥ 10 ，
 道 磁存储 单 ，
 并 存 ； ≥ 20 ，
 / / 标 ≥ 2 。

大 材
 材 泵 半导
 ()
 ： 饱 (SESAM) 材 长

低 长 ， 饱 ， 带 弛 ，



出单 低 单 ，
 ， 撑 波 测 测 等 ； **2m**
 波 、 Tm/Ho 掺 大、
 、 等 ， 出 **2m**波
 ， 撑 场 等 的 。
 标： 1 μm 波 单 ： 波长~1.0 μm，
 单 出 ≥ 1 kW， <10 kHz， <1 MHz/30min，
 <-160 dB/Hz， 不 <1%， 比 ≥ 55
 dB， M²<2。 2μm 波 ： 波长 1.8~2.2μm，
 出 ≥ 1 kW， <0.05 nm， 不 <5%， 比
 ≥ 30 dB， M²<2。 ≥ 6 ， 标
 ≥ 6 。

材 测 ()

： 、 、 TW
 测 ， 测 。 、
 测 ， 测 。
 、 、 ，
 并 的 。
 标： 测 ≥ 0.6J/cm²@515
 nm&1030 nm、 ≥ 0.2J/cm²@343nm， 测 不 <8%，
 <500fs； 比 ≥ 40 dB@1053 nm&1064 nm， 测 不

$<10\%$ @30 dB, 0~10000V ($<15\text{ns}$)。包
 的、等。
 代、变、等并
 , 100 。 6 , 标 Zemax、
 Code V 的 , 产 。
 ≥ 5 , ≥ 3 , / / 标 ≥ 2 。
 备表 (础)
 : 材的
 , 材 备表 备,
 材 的 , 材 成、
 、 、 等
 的 , 、大尺
 寸低 的 、大尺寸波长 的
 、大 安 波
 单 等材 的 , 大 材
 。
 标: 材 1
 的材 1 ,
 材 备表 ≥ 2 ()。 :
 边 $<200\text{ nm}$ 、尺寸 $\geq 4\times 4\times 5\text{ mm}^3$; 尺寸 $\geq 8\times 8\times 30$
 mm^3 , 泵 波长处 $<0.03\text{ cm}^{-1}$, 波 长波 出
 别 $\geq 5\text{ W}$ 。 : 尺寸 $\geq \Phi 50\times 50\text{ mm}^2$, $\geq 5\text{ W}$,

波长 570~590 nm; 1.55 μm : 尺寸 $\geq 60 \times 60 \times 40$
 mm^3 , $\geq 2\text{kW}$, $\geq 500 \text{ kHz}$; 单 :
 达百 μm , 10%, 单 出
 $\geq 50\text{W}$ 。 ≥ 5 , / / 标 ≥ 2 ,
 报 1 。

氮 半导 的

: Micro-LED 从 尺 、 从
 的 尺 、 超表
 的 长 备 ; 包 表 等 、
 等 的 成 , 超
 、 等 ; 超 、 超低
 的 , 的 。

标: 衬底 (≥ 2 寸) :
 单 尺寸 $< 500 \text{ nm}$, 辨 $\geq 10000 \text{ ppi}$, IQE \geq
 50%; 超 : 表 等 、
 的 比 $< 1 \text{ kW/cm}^2$ 。 10 , PCT
 2 。

材

: 材 备、
 , 的 备 ,
 场 的 ,

， 场 ， ，
 。
 标：单 ， 辨 640×480，
 尺寸<800 nm×800 nm， ≥ 1000 cd/m²， ≥
 10%。 ≥ 10 ， PCT ≥ 2 。

超

： SiC 超 的 场
 ； 超 参 的 ，
 低比导 的 ； 场
 的 保 ； 比超
 ； 低比导 的 SiC 超 ；
 超 的 并 。
 标： SiC 超 的 础 ，
 参 的 ；
 超 比 ≥ 5:1， ≥ 3.3 kV， 比导
 ≤ 6 mΩ·cm²； ≥ 5 。

带半导 半导 的单 成

： GaN 带半导 Si 的
 ； 大尺寸 GaN 单 薄 的剥 ；
 成 GaN Si 半导
 的 ； 单 成 GaN Si 的材

磁 ; 单 成的 GaN Si 的

。

标: GaN Si(100)半导 单 成 GaN
薄 错 $< 1 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}$, \geq
2000 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, $< 400\Omega/\text{sq}$; 单 成 的 GaN
 $\geq 40 \text{ GHz}$, 6GHz 出 \geq
3.5W/mm, $\geq 50\%$, 150°C MTTF 大 10^6
; Si(100) NMOS 的饱 $\geq 100\text{mA}/\text{mm}$, 比
 $\geq 10^5$, 125°C MTTF 大 10^6 ; ≥ 5 。

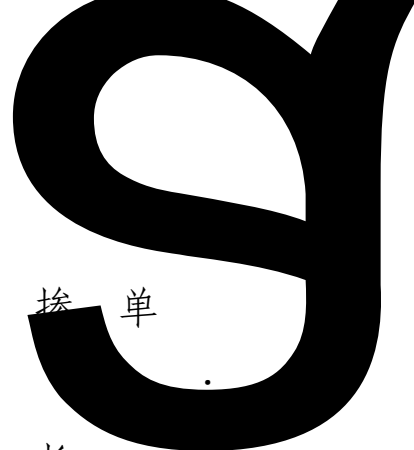
单 长

: GaN 单 衬底材 的 长 ;
GaN 长 的成 、传 、 长 ; GaN
背 、 等 ; GaN 错产 、
、 ; GaN 氨 长 的 、
; GaN 长 的 大尺寸
长 。

标: 长 备的 GaN 单 ≥ 2 寸、
 $\geq 1 \text{ cm}$, 2 寸 错 $< 1 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$; n GaN
单 衬底 $< 20 \text{ m}\Omega\cdot\text{cm}$, 半 GaN 单 衬底 \geq
 $1 \times 10^8 \Omega\cdot\text{cm}$; ≥ 5 。

大 的 材

: 单 掺 ,



导，掺；掺单
 ，产长，
 低大尺寸单
 大尺寸长备、等
 ；超表
 低成。
 标：掺单材：掺 $\geq 10^{17} \text{cm}^{-3}$ ，
 (400) 的 XRD 摆半 $< 60 \text{arcsec}$ ，的
 半 $< 4 \text{cm}^{-1}$ 。单材：尺寸 $\geq 20 \times 20 \times 30$
 mm^3 ，N、Si 等 $< 1 \text{ppm}$ ，B $< 1 \text{ppb}$ ，(400)
 的 XRD 摆半 $< 50 \text{arcsec}$ ，的半
 $< 3 \text{cm}^{-1}$ ， $< 10^5 \text{cm}^{-2}$ 。：
 $\geq \Phi 30 \text{mm}$ ， $< 4 \times 10^{-4} \text{cm}^2 \text{K/W}$ 。 \geq

5。

氮半导材的单元
 ：薄材的
 ，成备；

胞 >5 的 ; >1 胞/
， 胞 别 $>98\%$; 胞 ≥ 2 ;
 ≥ 5 的 胞 ≥ 3 的 床 胞 的 测 ;
床 ≥ 500 ; ≥ 4 。



“电材”点 2021 度“榜挂”榜单

彻 “ ” ，
产 ， “ 材 ”
、 、
， 成 “ 榜 ” 榜 ， 榜
布。

一、报 明

本 榜 、 板、 、 车
、 、 半 测
场 ， 产 材
备 、 车 程 、 程
程 产 产 ，
， 安 拔 不 。除 ，
榜 持 。 不超 ，
参 不超 (、 参
不超)。 ，
本榜 、 、 、 采 部 ((部
称 标)。 、 ，
报 。 、 、

报，报不
。
报“不”，报参册
()、称。报
不持榜，按程
。榜编，
“”。

二、攻关和核求

榜，榜“”，“程碑”
、拔、惩成，并榜
标摆出，。()
)榜，不。
程，，
察、测、测“程碑”，并
拔，不。
场、测场，
场，并充，成败。
不，败，按
，并诚。

三、榜单任务

1. OLED 产 (部)

标：出 产 出 材
，并 产 ， 材 备
备 产 。 标：

() 材 成 、 ≥
(产 材 ； 材
， 材 ≥)，

变。

() 测 ，
： ≥ 、
≥ ， ≥ ≥ 、
≥ ， ≥ ≥ 、
≥ 。

() 持
； ， 标：
() ， 辨 ；



采 ≥ ； 采 ≥ ，
， ， 采 。

() 材 备， 产 。

： 。

： 材 备
， 材 材 材 产 。

标: 材  , 材
≥ , 变;
测 , :
≥ 、 ≥ ,
≥ ≥ 、 ≥ ,
≥ ≥ 、 ≥ ;
。
: 材 产
。

标: 材 成  、
≥ (产 材 ; 材
 , 材 ≥);
测 , :
≥ 、 ≥ ;
材 备 备 , 产 ;
 , 持;
 , 。

榜 : 不超 。
: 成
测 。

2. OLED/QLED 产 (部)

标: 产

标, 出

材, 出备 产 备。

标 :

() 测 ,

标 : \geq 、

\geq , \geq \geq 、

\geq , \geq \geq 、

\geq 。

() 测 ,

标 : \geq 、

\geq , \geq \geq 、

\geq , \geq \geq 、

\geq 。

, \geq , 。

() 备 标 :

, , \geq , 辨

, \geq ,

出 (板尺) 备,

\geq 、 辨 \geq 。

() 材 备并 产 。

, 。

：

：

材

。

标：

测，

标：

≥、

≥， ≥

、 ≥， ≥

≥、 ≥； 测

， 标：

≥、 ≥， ≥

≥、 ≥， ≥

≥、 ≥。

：

材

。

标：

测，

标： ≥、

≥， ≥、

≥， ≥

、 ≥； 测，

标：

≥、 ≥， ≥

≥、 ≥， ≥

≥ 、 ≥ 。
： 材
， 产 研。
标： 测 ，
标 ： ≥ 、
≥ ， ≥ ≥
、 ≥ ， ≥
≥ 、 ≥ ； 测
， 标 ：
≥ 、 ≥ ， ≥
≥ 、 ≥ ， ≥
≥ 、 ≥ ； 材
备 成 。
榜 ： 不超 。
： 成
测 。

3. 车 SiC 材 (部)

标： 车 、 材 、
， 车 材 、 、
。 标 ：
() 出

, \geq , \geq
 , \geq , 比 $<$, \geq
 \geq 。
 () 出 , ,
 \geq ; 出 , \geq
 , \geq 。
 () 车 材 、 产 ,
 产 车 ; \geq
 , 标 \geq 。
 () 产 车
 ; 产成本 ,
 , 车 采 。
 : 。
 : 出车 。
 标: 比 $<$, \geq 。
 : 比 $<$
 , \geq ; \geq ;
 \geq , 并 车 。
 : 比 $<$
 , \geq ; \geq ;
 \geq , 。
 榜 : 不超 。

： 不 ， 。
4. 5G GaN Sub-6 GHz 波材

(部)

标:

波材 ， 成 产 ，
并 。 标 :

() 衬 <

， < ， 不 < 。

() 、 、

别 ≥ 、 、 ，

≥ ， 饱 ≥ 。

() 波 别 、

， 饱 ≥ ， 出 ≥ 。

() ≥ ， 标 ≥ 。

产 ； 部 产 超

， 出 超 。

：

： 产 标， 。

： 产 ，

， 不 。

榜 ： 不超 。

5. 、

标: 、 冲 、 超
 、
 , 并 。 标 :
 () : \geq , \geq , 插
 、 比 \geq 、 \geq ;
 : \geq , \geq , 插 、
 比 \geq 、 \geq , \geq
 ; : \geq , \geq , 插
 、 比 \geq 、 \geq 。
 () : : \geq ,
 \geq , \geq , \geq ;
 : , 插 ,
 比 \geq , 比 \geq , \geq 。
 () 、 : \geq ,
 \geq ; 、 \geq
 , 承 \geq 、 \geq 、 \geq
 ; , 尺
 。
 : 。
 : \geq ,
 。
 : , 标

除 标。

标: 。

，
材 ，
。

: 部 标，
部 标。

标: ， 材 ，
，
， 尺 。
、 、
不 ， 不 。

榜 : 不超 。

6. (部)

标: 程 测 备

，
、 长 半 备 产厂 测 。

标 :

() 出 : 波长 ，
出 \geq (波) ， 冲 \geq ()
波) ， 不 ()
， ()

，
（ ） 半 测 备 ；
半 测， 测成 辨 。
（ ） 、 产 ，

。
：
：
标： 波长 ， 出 \geq
（ 波） ， 冲 \geq （ 波）

。
：
标： 波长 ， 出 \geq
（ 波） ， 冲 \geq （ 波）
， 不 （ ） ，
（ ） ，

。
：
半 初步
标： 半 测 ， 测成 辨
。
：
半

标： 半 测 ， 测成 辨

。

榜 ： 不超 。

： 不 ， 。

“新型显示与战略性电子材料”重点专项 2021年度项目申报指南和榜单 形式审查条件要求

申报项目须符合以下形式审查条件要求。

1. 推荐程序和填写要求

() 由指南规定的推荐单位在规定时间内出具推荐函。

() 申报单位同一项目须通过单个推荐单位申报，不得多头申报和重复申报。

() 项目申报书（包括预申报书和正式申报书，下同）内容与申报的指南方向（榜单任务）相符。

() 项目申报书及附件按格式要求填写完整。

2. 申报人应具备的资格条件

() 项目（课题）负责人应为 年 月 日以后出生，具有高级职称或博士学位。

() 青年科学家项目负责人应具有高级职称或博士学位，男性应为 年 月 日以后出生，女性应为 年 月 日以后出生。原则上团队其他参与人员年龄要求同上。

() 受聘于内地单位的外籍科学家及港、澳、台地区科学家可作为项目（课题）负责人，全职受聘人员须由内地聘用单位提供全职聘用的有效材料，非全职受聘人员须由双方单位同时提供聘用的有效材料，并作为项目预申报材料一并提交。

() 项目 (课题) 负责人限申报 个项目 (课题) ; 国家科技重大专项、国家重点研发计划、科技创新 一重大项目的在研项目负责人不得牵头或参与申报项目 (课题) , 课题负责人可参与申报项目 (课题) 。

() 参与重点专项实施方案或本年度项目指南编制的专家, 原则上不能申报该重点专项项目 (课题) 。

() 诚信状况良好, 无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用 “黑名单” 记录。

() 中央和地方各级国家机关的公务人员 (包括行使科技计划管理职能的其他人员) 不得申报项目 (课题) 。

3. 申报单位应具备的资格条件

() 在中国大陆境内登记注册的科研院所、高等学校和企业等法人单位。国家机关不得作为申报单位进行申报。

() 注册时间在 年 月 日前。

() 诚信状况良好, 无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用 “黑名单” 记录。

4. 本重点专项指南规定的其他形式审查条件要求

() “揭榜挂帅” 项目 (课题) 负责人无年龄、学历和职称要求, 项目牵头申报和参与单位无注册时间要求。

() 青年科学家项目不再下设课题, 项目参与单位总数不超过 家。

本专项形式审查责任人: 杨斌

“新型显示与战略性电子材料”重点专项 年度项目申报指南和 榜单编制专家名单

	樊	国 创	副 长
		技集 股份 公	教 级高级工程
	郭	福 大 工程	教
		第 代半导 产 技 创	长
	波	北 大	教
	大	东方 技集 股份 公	教 级高工 副 裁
	建	大 技	教
		国 半导	副 长
	蔡	国电 技集 第	教 级高工 副 长
		国 福建 构	副 长
		华 工大 光电	教 长
		国 化技	
	 成	安电 技大	教
	金	大	教
		华 技大 机 工程	教 常 副 长